



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H01L 21/3065, 21/304, 21/205, 21/31, C23C 16/44, 16/50, C07C 19/08, 49/167, C07D 303/08	A1	(11) 国際公開番号 WO98/01899 (43) 国際公開日 1998年1月15日(15 01.98)
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/02369</p> <p>(22) 国際出願日 1997年7月9日(09.07.97)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平8/180518 1996年7月10日(10.07.96) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)(JP/JP) 〒530 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 板野充司(ITANO, Mitsushi)(JP/JP) 〒566 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 三枝英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.) 〒541 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 北浜TNKビル Osaka, (JP)</p>		(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書
<p>(54) Title: CLEANING GAS</p> <p>(54) 発明の名称 クリーニングガス</p> <p>(57) Abstract A chamber cleaning gas for Si films, SiO<sub>2</sub> films, Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub> films or high-melting metal silicide films, which comprises at least one gas selected from the group consisting of those represented by formulas: (a), (b) and (c); and a process for cleaning a chamber.</p>		
<p>CF<sub>3</sub>CF=CF<sub>2</sub> (a)</p> <p>CF<sub>3</sub>CF—CF<sub>2</sub> (b)</p> <p>CF<sub>3</sub>C=O (c)</p>		